

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Фізичний факультет
(назва факультету)

Кафедра загальної фізики



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана
навчальної роботи

Момот О.В.

2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Нанофізика напівпровідників

(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів

галузь знань 10 Природничі науки
(шифр і назва)
спеціальність 104 Фізика та астрономія
(шифр і назва спеціальності)
освітній рівень магістр
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
освітня програма Фізика
(назва освітньої програми)
спеціалізація Фізика наносистем
(за наявності) (назва спеціалізації)
вид дисципліни обов'язкова

Форма навчання

очна

Навчальний рік

2019/2020

Семестр

3

Мова викладання, навчання
та оцінювання

українська

Форма заключного контролю

залік

Викладачі: професор Коротченко Олег Олександрович

(Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання даної дисципліни у відповідному навчальному році)

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)


на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2019

Розробник¹: Коротченков Олег Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри загальної фізики
(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. кафедри загальної фізики



(підпис)

(Боровий М.О.)
(прізвище та ініціали)

Протокол № 10 від 7 травня 2019 р.

Схвалено науково-методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 21 від «10» травня 2019 року

Голова науково-методичної комісії



(підпис)

(Оліх О.Я.)
(прізвище та ініціали)

¹ Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної роботи (заступником директора коледжу).

ВСТУП

1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематизованих знань з фізики низькорозмірних напівпровідників, що включає засвоєння основних явищ та фізичних закономірностей у даному класі напівпровідників, оволодіння методами і принципами як теоретичного розв'язку фізичних проблем, так і планування та виконання фізичного експерименту в галузі фізики низькорозмірних напівпровідникових систем.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати

основні питання фізики низькорозмірних напівпровідників, зокрема: загальні положення фізики напівпровідникових наносистем; основні сучасні уявлення напівпровідникових нанотехнологій, застосування низькорозмірних напівпровідникових систем у практичних пристроях;

2. Вміти

застосовувати на практиці методи квантової механіки та фізики твердого тіла для опису властивостей низькорозмірних напівпровідників; логічно і послідовно формулювати основні закономірності визначення енергетичних станів у низькорозмірних напівпровідниках; самостійно працювати з науковою літературою в галузі фізики напівпровідникових наносистем;

3. Володіти

основними навичками розв'язку типових задач квантової механіки та фізики твердого тіла, методами розрахунку енергетичного спектру носіїв заряду у нано-розмірному середовищі та розрахунків з використанням кінетичного рівняння Больцмана в наближенні часу релаксації;

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

В рамках курсу «Фізичні властивості наносистем» розглядаються як класичні, так і сучасні досягнення в області опису фізичних закономірностей та практичного використання напівпровідникових нанорозмірних систем.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння загальних положень фізики напівпровідникових наносистем, зокрема, явища екранування носіїв заряду, приповерхневого квантування, основи ємнісної спектроскопії, процесів саморегулювання при одержанні низькорозмірних напівпровідникових структур.

Навчальна задача курсу полягає в оволодінні основними методами одержання та дослідження напівпровідникових наносистем, включаючи квантові ями, дроти, точки, надгратки.

Результати навчання полягають в умінні застосовувати знання із основ функціонування та застосування низькорозмірних напівпровідникових систем. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи.

Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, оцінювання лабораторних робіт, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та заліку (40%).

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з фізичними основами функціонування низькорозмірних напівпровідникових систем та основами напівпровідникових нанотехнологій.

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», ОНП

«Фізика наносистем») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних **компетентностей**:

Інтегральних:

Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі фізики наносистем, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань.

Загальних:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу **(ЗК1)**.
- Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні **(ЗК3)**.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел **(ЗК4)**.
- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі **(ЗК5)**.
- Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі фізики **(ЗК6)**.

Фахових:

- Володіння принципами структурної побудови наносистем **(ФК1)**.
- Володіння принципами функціональної побудови наносистем **(ФК2)**.
- Володіння методами створення наносистем **(ФК3)**.
- Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи дослідження наносистем та діагностики наносистем **(ФК4)**.
- Здатність застосовувати знання теорій опису фізичних властивостей наносистем різних типів **(ФК5)**.
- Здатність застосовувати знання з фізики нанорозмірних напівпровідників **(ФК6)**.
- Здатність застосовувати знання з нанофотоніки, оптичних та фотоелектричних явищ в наноструктурах. **(ФК8)**.
- Здатність застосовувати знання в галузі методів вимірювання фізичних властивостей наносистем **(ФК14)**.

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)		Методи викладання і навчання	Методи оцінювання	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знання основ фізики нерівноважних відкритих систем (ПРН 1.9).	лекції	Модульна контрольна робота	30
1.2	Знання аналітичних та чисельних методів опису кінетики процесу кристалізації рідких та аморфних систем (ПРН 1.12).	лекції	Модульна контрольна робота	5
2.1	Вміння визначати тип легування напівпровідника і тип транзистора та їх енергетичних зонних структур (ПРН 2.1).	лекції	Модульна контрольна робота	10
2.2	Вміння розраховувати перерозподіл заряду, потенціалу і поля на поверхні і границях розділу фаз, оцінювати ступінь локалізації електронів і визначати роботу виходу електронів (ПРН 2.3).	лекції	Модульна контрольна робота	15

* заповнюється за необхідністю, наприклад для практик, лабораторних курсів тощо.

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов'язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни	1.1	1.2	2.1	2.2
Програмні результати навчання				
ПРН 1.9. Знати основи фізики нерівноважних відкритих систем.	+			+
ПРН 1.12. Знати аналітичні та чисельні методи опису кінетики процесу кристалізації рідких та аморфних систем.		+		

Структура курсу

Курс складається з 2-х змістових модулів: «Фізичні основи функціонування низькорозмірних напівпровідникових систем», який включає в себе 7 лекцій та «Вступ до напівпровідникових нанотехнологій», який складається з 8 лекцій.

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Max. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1. Модульна контрольна робота 1 (18 балів-30 балів).
2. Модульна контрольна робота 2 (18 балів-30 балів).

- підсумкове оцінювання у формі заліку

Підсумкове оцінювання у формі екзамену²: (обов'язкове проведення екзаменаційного оцінювання в письмовій формі)

	ЗМ1/Частина 1 (за наявності)	ЗМ2/Частина 2 (за наявності)	залік	Підсумкова оцінка
Мінімум	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>24</u>	<u>60</u>
Максимум	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>100</u>

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.³

(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).

Оцінка за залік не може бути меншою **24 балів** для отримання загальної позитивної оцінки за курс.

7.2. Організація оцінювання: (обов'язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).

7.3. Шкала відповідності

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail	35-59
Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни / Fail	0-34

² Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (**100 балів** - для залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким алгоритмом: **60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен**).

³ У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – **20 балів**, а рекомендований мінімум **не менше 36 балів**, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше **24 балів** (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони **не додаються** до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.

Зараховано / Passed	60-100
Не зараховано / Fail	0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п	Назва теми	Кількість годин		
		лекції	лабораторні	Самостійна робота
Частина 1. Фізичні основи функціонування низькорозмірних напівпровідникових систем.				
1	Тема 1. Вступ. Просторово-неоднорідні рівноважні розподіли концентрацій носіїв заряду. Екранування. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Рівняння Пуассона у k -просторі. Радіус екранування в рамках теорії Дебая-Хюккеля та Фермі-Томаса.	4		6
2	Тема 2. Енергетичні діаграми p - n -переходу. Дифузійна та бар'єрна ємності. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. p - n -перехід та його енергетична діаграма. Ємність p - n -переходу. Приповерхнєве квантування. Інжекція неосновних носіїв заряду в p - n -переході. Фотоелектричні властивості p - n -переходів.	4		6
3	Тема 3. Ємнісна спектроскопія низькорозмірних напівпровідникових систем. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Ємнісна спектроскопія квантових точок. Вольт-фарадні характеристики. Вимірювання стаціонарної та нестаціонарної ємності у темряві і при освітленні. Нестационарна ємнісна спектроскопія глибоких рівнів для дослідження наноструктур.	4		6
4	Тема 4. Методи отримання плівкових квантово-розмірних структур. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до модульної контрольної роботи 1. Вимоги до технології отримання квантово-розмірних структур на основі гетеропереходів. Хімічні аналоги. Близькість сталих ґратки. Різкість гетеромережі. Основні методи отримання плівок. Хімічне осадження з газової фази. Парофазна епітаксія з металоорганічних сполук. Молекулярно-пучкова епітаксія. Електрохімічне осадження. Фізичні основи методів, заснованих на використанні скануючих зондів. Атомна інженерія. Зондові методи створення низькорозмірних структур.	2		10
	Контрольна робота 1			2
Частина 2. Вступ до напівпровідникових нанотехнологій.				
5	Тема 5. Методи зниження розмірності плівкових квантово-розмірних структур. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Нанолітографія. Електронно-променева літографія. Зондова нанолітографія. Нанодрук. Порівняння нанолітографічних методів. Спеціальні методи зниження розмірності. Вирощування наноструктур на мікроскопічно	2		6

	упорядкованих фасетированих поверхнях.			
6	<p>Тема 6. Процеси саморегулювання при одержанні низькорозмірних напівпровідникових структур. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.</p> <p>Самоорганізація в об'ємних матеріалах. Отримання колоїдних розчинів напівпровідників. Самоорганізація квантових точок і ниток при епітаксії. Режими зростання гетероепітаксійних структур Франка-ван дер Мерві, Фольмера-Вебера, Странського-Крастанова. Типи наноструктур, одержаних з використанням ефектів самоорганізації. Вирощування тривимірних масивів когерентно-напружених острівців в гетероепітаксійних разупорядкованих системах. Вирощування поверхневих структур плоских пружних доменів. Вирощування наноструктур з періодичної модуляцією складу в епітаксійних плівках твердих розчинів напівпровідників. Поняття про молекулярні наноструктури. Органічні напівпровідникові молекули. Супермолекули. Біомолекули.</p>	6		6
7	<p>Тема 7. Основні методи дослідження низькорозмірних напівпровідникових структур. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.</p> <p>Поняття про основні методи дослідження низькорозмірних напівпровідникових структур: дифракція повільних електронів, просвічуюча електронна мікроскопія, автоелектронна й автоіонна мікроскопія, зондова мікроскопія, дифракційний аналіз, EXAFS-спектроскопія, оптичний спектральний аналіз, використання кінетичних електричних та теплових явищ для дослідження низькорозмірних напівпровідникових структур.</p>	4		6
8	<p>Тема 8. Основні типи низькорозмірних напівпровідникових структур. с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.</p> <p>Структури з двовимірним електронним газом. Структури з квантовим обмеженням, створюваним зовнішнім електричним полем. Структури метал/діелектрик/напівпровідник. Структури з розщепленим затвором. Структури з квантовим обмеженням, створюваним внутрішнім електричним полем. Надгратки. Композиційні та леговані надгратки. Квантові ями. Модуляційно-леговані структури. Дельта-леговані структури. Структури з одновимірним електронним газом. Структури з нуль-мірним електронним газом. Спінові ефекти у низькорозмірних напівпровідникових системах.</p>	4		10
	Підсумкова модульна контрольна робота			2
	ВСЬОГО	30		60

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення

Загальний обсяг 90 год.⁴, в тому числі:

Лекцій – 30 год.

Семінари – 0 год.

Практичні заняття – 0 год.

Лабораторні заняття – 0 год.

Тренінги – 0 год.

Консультації - ___ год.

⁴ Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.

Питання для самостійної роботи

1 модуль

1. Кінетичні ефекти в двовимірних системах: час релаксації та рухливість, вертикальний перенос в системі квантових ям.
2. Кінетичні явища в сильних магнітних полях. Дробний квантовий ефект Холла.
3. Домішкові стани в напівпровідникових системах зниженої розмірності.
4. Кулонівські зв'язані стани та інтерфейсні дефекти в гетеро структурах.
5. Технологія вирощування Si/Ge гетероструктур.

2 модуль

1. Квантовий транспорт: ідеї локалізації, термоактивована провідність в режимі локалізації, теорія Таулесса.
2. Виміри магнітних полів методами квантової магнітометрії.
3. Біомедичні наноструктури: мікро/нано двигуни та їх біомедичне застосування, новітні наноструктури як молекулярні нанодвигуни, наноструктури для транспорту ліків.
4. Епітаксія монокристалічних плівок. Гомо- і гетероепітаксія. Основи теорії зародкоутворення і зростання епітаксійних плівок при їх вирощуванні з газоподібних фаз.
5. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний підхід до опису гетероепітаксії.
6. Методи рідинної епітаксії. Епітаксія з газоподібної фази: метод хімічних реакцій, газотранспортна епітаксія. Конденсація з парової фази.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА⁵:

Основна: (Базова)

1. Шпак А.П., Куницький Ю.А., Коротченков О.О., Смик С.Ю. Квантові низькорозмірні системи. Київ, 2003, 312 с.
2. Коротченков О.О. Вступ до фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Властивості гетеропереходів, Київ: Бавок, 2011, 48 с.
3. Подолян А.О., Коротченков О.О. Фізика низькорозмірних напівпровідників. Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Фотоелектричний ефект, Вінниця: ТОВ "Твори", 2018, 64 с.
4. Воробьев Л.Е., Голуб Л.Е., Данилов С.Н., Ивченко Л.Е., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А. Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах. СПб. 2000, 156 с.
5. Гридчин В.А., Драгунов В.П., Неизвестный И.Г. Основы нанoeлектроники: Учебное пособие. М.: Физматкнига. 2006, 496 с.
6. Davies J.H. The physics of low-dimensional semiconductors. Cambridge Univ. Press, 1998, 438 p.
7. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика низкоразмерных систем. СПб.: Наука. 2001, 160 с.
8. Борисенко В.Е., Воробьева А.И., Уткина Е.А. Нанoeлектроника: Учебное пособие, в 3-х частях. Минск: БГУИР. 2004, 205 с.
9. http://bookwu.net/book_nanoelektronika

Додаткова:

1. Datta S. Electronic transport in mesoscopic physics. Cambridge Univ. Press, 1995, 377 p.
2. Bastard G. Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures. Les Editions de Physique, 1991, 358 p.
3. Bimberg D., Grundmann M., Ledentsov N.N. Quantum dot heterostructures. Wiley, 1999, 328 p.

⁵ В тому числі Інтернет ресурси

4. Строшио М., Дутта М. Фононы в наноструктурах. М.: Физматлит. 2006, 320 с.
5. Александров Е.Б., Вершовский А.К. Современные радиооптические методы квантовой магнитометрии. Успехи физических наук. 2009, Т. 179, С. 605-637.
6. Gonsalves K.E., Halberstadt C.R., Laurencin C.T., Nair L.S. Biomedical nanostructures. Wiley, 2008, 516 p.
7. Дмитриев А.С. Введение в нанотеплофизику. М.: БИНОМ, 2015. – 792 с.
8. <http://vlp.com.ua/node/2785>
9. http://me.kpi.ua/downloads/Poplavko_Nanophysics_2012.pdf
10. http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/fragments/azarenkov_-_kopiya.pdf